

## Транзисторная сборка 1НТ251

состоит из четырех кремниевых эпитаксиально-планарных переключаемых транзисторов структуры n-p-n. Предназначена для применения в переключающих устройствах. Выпускаются в металлокерамических корпусах с гибкими выводами. Тип корпуса: 401.14-6. Технические условия: И93.456.000 ТУ.

### Основные технические характеристики транзисторной сборки 1НТ251:

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора	400 мВт
Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером	не менее 200 МГц
Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора и заданном сопротивлении в цепи база-эмиттер	45 В (1кОм)
Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора	4 В
Максимально допустимый постоянный ток коллектора	400 мА
Максимально допустимый импульсный ток коллектора	800 мА
Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера	не более 6 мкА (45В)
Статический коэффициент передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером	30...150
Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером	не более 1000 Ом